Розрахунок надійності

Надійність елементів ЕОА

Найбільш масові елементи EOA: DD, R, C, VT, VD, роз'єми і т.д. Відмова одного чи декількох елементів веде до відмови всієї складної EOA, при чому *ці елементи фактично є невідновлюваними*.

по інтенсивності відмов вони між собою не рівноцінні. Для визначення інтенсивності відмов в реальних умовах необхідно враховувати режими та умови, в яких працює та експлуатуються елементи, а відповідно і весь пристрій.

При номінальних умовах $\lambda_{\rm e} = \lambda_{\rm 0e}$

Інтенсивність відмов елементів $\,\lambda_{\mathrm{0e}}\,$ при номінальних умовах

Елементи	$\lambda_{\mathrm{0e}} \cdot 10^{-7} 1_{\mathrm{rog}}$
Резитори С2-23-0.125	0,02
Конденсатори К50-6	0,5
Конденсатори керамічні	0,3
Транзистори: малопотужні	0.15 - 0.37
середньої потужності	1,21
великої потужності	1,59
Транзистор KT315	0,88
Мікросхеми К555	0,2
Контакт роз'єму (друкований роз'єм -контакт роз'єму; навісний роз'єм - контакт + пайка одного виводу)	0,2
Друкована плата (1 сторона)	1
Пайка виводів дискретних компонентів	0.5 * 10-9

Надійність друкованого вузлу визначається *надійністю* **всіх** елементів, що встановлюються да ДП, власне самою ДП на пайкою елементів.

Визначимося з номінальними умовами.

Під **номінальними умовами** розуміють роботу елементу при $K_{\rm H}=1$, $t_{\rm cp}^{\circ}=25\pm5$, влогість повітря $65\pm5\%$, P=760mm. Певне середовище не містить пилу, вільна від руйнувальної дії газів, солей, Елементи не випробовують ударів та вібрацій. З визначення слідує номінальні умови.

Елементи працюють в реальних режимах та умовах.

Режим роботи елемента визначається як

$$\lambda_{\alpha} = \varphi(W, I, U)$$

Режим роботи елементів оцінюється коефіцієнтом навантаження $K_{\rm H}$, що дорівнює відношенню величини параметру, що визначає навантаження елементу в схемі пристрою, до номінального значення цього параметру по паспорту або ТУ (data sheet).

Для різних елементів коефіцієнт навантаження визначається по різним параметрам (розсіювана потужність, протікаючий струм, прикладена напруга) або їх сукупність. Частіше

за все коефіцієнт навантаження визначається в статичному режимі, рідше по змінному струму.

$$K_{_{\rm H}} = \frac{{\sf H}_{_{{\sf po}6}}}{{\sf H}_{_{{\sf Ho}{\sf M}}}} = \frac{{\sf навантаження робоче}}{{\sf навантаження номінальне}}$$

Н_{роб} - визначається зі схеми

Н_{ном} - визначається з довідника

Коефіцієнт навантаження елементів визначається (для конкретних елементів):

$$K_{{
m H}_{\!\scriptscriptstyle W}} = rac{{
m W}_{
m po6}}{W_{{
m H}_{
m OM}}}$$
 - для VT, R, IC $K_{{
m H}_{\!\scriptscriptstyle U}} = rac{{
m U}_{
m po6}}{U_{{
m H}_{
m OM}}}$ - для C, VD

$$K_{_{\mathrm{H}_{I}}}=rac{\mathsf{I}_{\mathrm{po6}}}{I}$$
 - для VD, IC, VT

 $K_{\rm H}$ не повинен перевищувати 1, бажано $K_{\rm H}$ зменшувати, однак при малих (наприклад $K_{\rm H}=0.1$ маємо значний запас по надійності, але при цьому значно зростають габарити та вага. Рекомендується брати $K_{\rm H}=0.5\div0.8$.

Для елементів H_{po6} розраховується, вимірюється, ... по результатам схемотехнічного проектування. $H_{\text{ном}}$ - з довідника. Тоді

$$\lambda_{\rm e} = \lambda_{\rm oe} K_{\rm H}$$

Залежність інтенсивності відмов германієвих та кремнієвих транзисторів від $K_{\scriptscriptstyle
m H}$ представлено в таблиці

Кн	не більше 0.1	0.1 - 0.4	0.4 - 0.8
Германієві	$\lambda = 0.3 \cdot 10^{-7}$	$0.5 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$
Кремнієві	$\lambda = 0.15 \cdot 10^{-7}$	$0.3 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-7}$

На надійність елементів **впливають** не тільки електричні режими, а також зовнішні фактори:

- температура
- вологість
- тиск

тобто кліматичні впливи.

Дискретні компоненти проектуються з урахуванням, що вони можуть використовуватися в пристроях різного призначення, в різних режимах та різних умовах експлуатації. *Умови експлуатації* суттєво впливають на надійність елементів, а відповідно на надійність всього виробу, тобто $\lambda_{\rm e} = f\left(T^{\,\circ}, P, F\right)$ - температура, тиск, вологість.

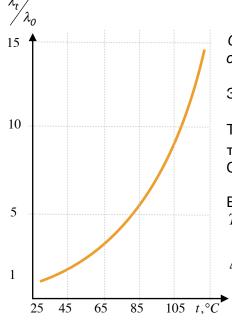
Зовнішні впливи враховуються відповідно a_{t} , a_{p} , a_{F} .

Приблизно можна рахувати, що середній час напрацювання (T_{cp}) до першої відмови зменшується на 10% при збільшенні температури оточуючого середовища на $\approx 5\%$. Ця залежність зберігається в діапащоні 10-60 С°.

В літературі приводять значення поправочних коефіцієнтів a_{t} , що показують в скільки разів інтенсивність відмов **при даному** $K_{\rm H}$ відрізняється від інтенсивності відмов при номінальних умовах при зміні температури.

$$a_{t} = \frac{\lambda_{e}(t_{p}^{\circ})}{\lambda_{e}(t^{\circ} = 25^{\circ}C)}\Big|_{K_{H} = const}$$

Залежність інтенсивності відмов ІС від температури має вигляд



Савельєв А.Я., Овчінніков В.А. Конструювання ЕОМ та систем (с.119)

Залежність відносної λ IC від температури.

Такі графіки a_i для резисторів, для конденсаторів різних типів, для діодів та транзисторів також наведені у Савельєва.

Вам прийдеться враховувати температуру, тому що $T_{p} = T_{{\scriptsize \mbox{\scriptsize HABK Ceped}}} + \Delta t_{{\scriptsize \mbox{\scriptsize HAPP 3OHU}}}$

 $\Delta t_{{\scriptscriptstyle HAPP\ 3OHU}}$ якщо збільшується на $10 \div 15^{\circ} C$, то значення a_{t} може збільшуватися в 10 разів (див. на графік)

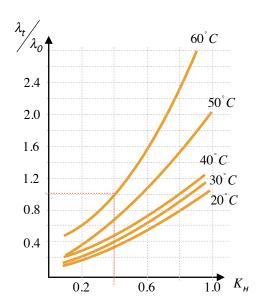
$$\lambda_e = \lambda_{oe} \cdot K_{\scriptscriptstyle H} \cdot a_{\scriptscriptstyle t}$$

Ми з вами навели приклади інтенсивностей відмов деяких окремих елементів (див. таблицю). Можна добавити, що $\lambda(t)$ для R та VT за останні 20 років зменшилося в 300 разів.

Побудова ЕОА III та IV поколінь на IC дозволило **на порядок збільшити** їх надійність. за прогнозами вчених $\lambda(t)$ IC може знизитися до $1\cdot 10^{-11} \frac{1}{r_{OA}}$.

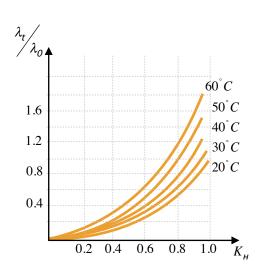
В Літературі наводяться значення коефіцієнтів в залежності від коефіцієнту навантаження (див. Савельєв А.Я., Овчініков В.А. Конструювання ЕОМ та систем).

Залежність відносної інтенсивності відмов від температури роботи та коефіцієнту навантаження

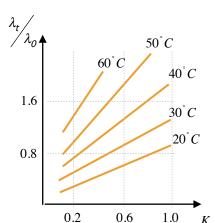


для резисторів

$$\lambda_{_{T_p=50^{\circ}C}} < \lambda_{_{T_p=60^{\circ}C}} \text{ при } K_{_{HT_p=50^{\circ}C}} < K_{_{HT_p=60^{\circ}C}}$$



для керамічних конденсаторів



для германієвих транзисторів

Таким чином в цих графіках враховується, що

$$a_{\scriptscriptstyle t} = f \big(t_{\scriptscriptstyle p} , K_{\scriptscriptstyle H} \big)$$

Умови експлуатації включають не тільки температурні впливи, але й механічні впливи. Механічні впливи враховуються поправочним коефіцієнтом $a_{\scriptscriptstyle b}$. Фізичний зміст є

аналогічним до a_{t} , тобто a_{b} показує в скільки разів інтенсивність відмов при даному K_{H} відрізняється від інтенсивності відмов при номінальних умовах при зміні впливів.

Узагальнений коефіцієнт, що враховує механічні впливи (вібрації, лінійні прискорення, удари, ...) представляють наступним чином:

$$a_e = \frac{\lambda_e}{\lambda_{ena6}}$$
,

 a_{e} є відношення λ_{e} в ЕОА різного призначення до $\lambda_{e n a \delta}$ елементів ЕОА, що використовується в лабораторних умовах, що відповідають найменшим рівням експлуатаційних впливів.

Відношення інтенсивності відмов елементів ЕА ризного призначення до інтенсивності відмов елементів лабораторної ЕА (див. Савельєв)

Тип ЕОА	$\lambda_{ m e}/\!$
стаціонарна наземна	20
корабельна	40
автомобільна	50
залізнодорожна	25-30
високогірна	80
літакова	120-150
лабораторна	1

З таблиці слідує, що надійність елементів ЕОА суттєво знижується зі збільшенням рівня механічних навантажень.

Таким чином результуюча інтенсивність відмов елементів і-го типу (одного й того є типу) з урахуванням впливів можна представити так:

$$\lambda_{PE} = \lambda_{0E} \cdot K_{H} \cdot a_{t} \cdot \dots \cdot a_{e\kappa\epsilon\eta}$$

для даного типу елементу. $\lambda_{\it PE}$ буде стільки, скільки типів елементів в схемі.